

THYRISTOR Type : TSN10A80

10A, 800V

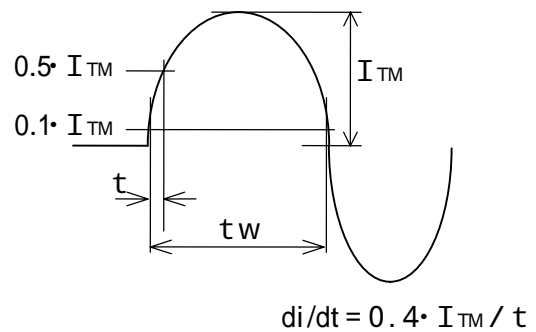
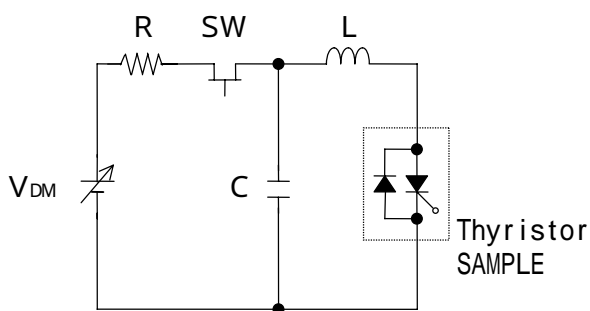
構造： シリコンプレーナ型逆導通サイリスタ

用途： HIDランプ点灯用
コンデンサ放電制御用
バラスト回路用

最大定格

| 項目 | 記号 | 条件 | 定格値 | 単位 |
|--------------------------------|-------------|--|------------|------------|
| 繰り返しピークオフ電圧 | V_{DRM} | $T_j = 25$ | 800 | V |
| 繰り返しピークオン電流 (注1) | I_{TRM} | $T_c 100, V_{DM} 400V$ $I_G 80mA, di/dt 0.5A/\mu s$ $t_w 1.0\mu s, di/dt 1500A/\mu s$ duty 0.005% | 500 | A |
| 繰り返しピーク順電流 (注1) | I_{FRM} | $T_c 100, t_w 1.0\mu s$ duty 0.005% | 500 | A |
| 臨界オン電流上昇率 オン電流降下率耐量 (注1) | di/dt | $T_a 100, V_{DM} 400V$ $I_G 80mA, dig/dt 0.5A/\mu s$ $I_{TM} 500A, t_w 1.0\mu s$ 50 Hz, 1 分間, ノイズ無し | 1500 | A/ μs |
| ピークゲート電力損失 | P_{GM} | f 50Hz, duty 10% | 5 | W |
| 平均ゲート電力損失 | $P_{G(AV)}$ | - | 0.5 | W |
| ピークゲート電流 | I_{GM} | f 50Hz, duty 10% | 2 | A |
| ピークゲート電圧 | V_{GM} | - | 10 | V |
| ピークゲート逆電圧 | V_{RGM} | - | 5 | V |
| 動作接合温度範囲 | T_{jw} | - | -40 ~ +125 | |
| 保存温度範囲 | T_{stg} | - | -40 ~ +150 | |

(注1) 回路及び波形



電気的特性 (Tj = 25)

| 項目 | 記号 | 条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 |
|---------------|----------------------|--|----|----|------|----|
| ピークオフ電流 | I _{DM} | V _{DM} = V _{DRM} | - | - | 100 | μA |
| ピークオン電圧 (サリタ) | V _{TM} | I _{TM} = 20A | - | - | 1.50 | V |
| ピーク順電圧 (ダイト) | V _{FM} | I _F = 10A | - | - | 1.50 | V |
| ゲートトリガ電流 | I _{GT} | V _{DM} = 6V , R _L = 10 | - | - | 20 | mA |
| ゲートトリガ電圧 | V _{GT} | | - | - | 1.0 | V |
| 保持電流 | I _H | I _G = 50mA , I _{TM} = 1A | - | 7 | - | mA |
| ラッチング電流 | I _L | I _G = 50mA | - | 13 | - | mA |
| 熱抵抗 | R _{th(j-c)} | 接合部 - ケース間 | - | - | 5 | /W |
| 熱抵抗 | R _{th(j-a)} | 接合部 - 周囲間 | - | - | 80 | /W |

外形図

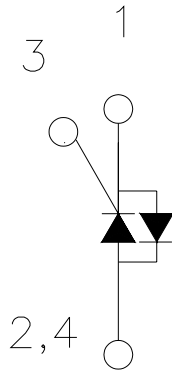
電極接続

○ : カソード

△ : アノード

□ : ゲート

重量 : 約 1.45 g



1: CATHODE

2,4: ANODE

3: GATE

